

2SB1012(K)

シリコン PNP エピタキシャル形

HITACHI

特長

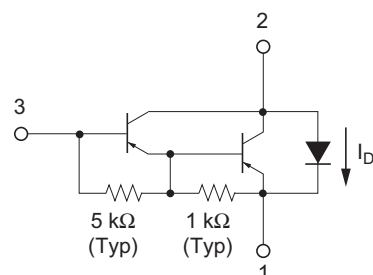
- 低周波電力増幅用
- 2SD1376(K)とコンプリメンタリペア

外観図

TO-126 MOD



1. Emitter
2. Collector
3. Base



絶対最大定格

(Ta = 25°C)

項目	記号	2SB1012(K)	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	-120	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-120	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-7	V
コレクタ電流	I_C	-1.5	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	-3.0	A
許容コレクタ損失	P_C^{*1}	20	W
接合部温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55~+150	°C
C-E間ダイオード順方向電流	I_D^{*1}	1.5	A

【注】 1. $T_C = 25^\circ\text{C}$ における許容値

電気的特性

(Ta = 25°C)

項目	記号	Min	Typ	Max	単位	測定条件
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	-120	—	—	V	$I_C = -10\text{mA}$, $R_{BE} = \infty$
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	-7	—	—	V	$I_E = -50\text{mA}$, $I_C = 0$
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	—	—	-100	μA	$V_{CB} = -120\text{V}$, $I_E = 0$
	I_{CEO}	—	—	-10	μA	$V_{CE} = -100\text{V}$, $R_{BE} = \infty$
直流電流増幅率	h_{FE}	2000	—	30000		$V_{CE} = -3\text{V}$, $I_C = -1\text{A}^{*1}$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)1}$	—	—	-1.5	V	$I_C = -1\text{A}$, $I_B = -1\text{mA}^{*1}$
	$V_{CE(sat)2}$	—	—	-2.0	V	$I_C = -1.5\text{A}$, $I_B = -1.5\text{mA}^{*1}$
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)1}$	—	—	-2.0	V	$I_C = -1\text{A}$, $I_B = -1\text{mA}^{*1}$
	$V_{BE(sat)2}$	—	—	-2.5	V	$I_C = -1.5\text{A}$, $I_B = -1.5\text{mA}^{*1}$
C-E間ダイオード順方向電圧	V_D	—	—	3.0	V	$I_D = 1.5\text{A}^{*1}$
ターンオン時間	t_{on}	—	0.5	—	μs	$I_C = -1\text{A}$, $I_{B1} = -I_{B2} = -1\text{mA}$
ターンオフ時間	t_{off}	—	2.0	—	μs	

【注】 1. パルス測定

